

2SB750, 2SB750A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形ダーリントン /
Si PNP Epitaxial Planar Darlington

低周波電力増幅 / AF Power Amplifier

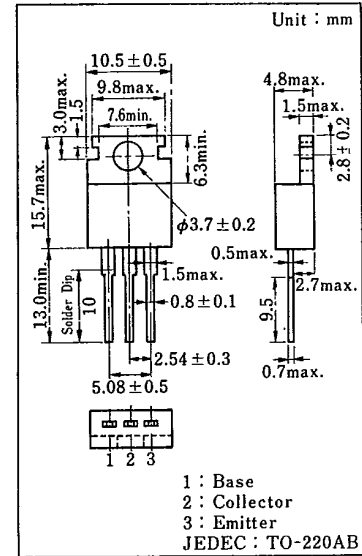
2SD836, 2SD836A とコンプリメンタリ / Complementary Pair
with 2SD836, 2SD836A

■ 特徴 / Features

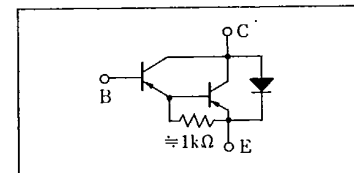
- 直流電流増幅率 h_{FE} が高い。 / High h_{FE}
- スイッチング速度が速い。 / High speed switching

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$-V_{CB0}$	60	V
	$-V_{CB0}$	80	V
コレクタ・エミッタ電圧	$-V_{CE0}$	60	V
	$-V_{CE0}$	80	V
エミッタ・ベース電圧	$-V_{EB0}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$-I_{CP}$	4	A
コレクタ電流	$-I_C$	2	A
コレクタ損失 (Tc = 25°C)	Pc	35	W
接合部温度	Tj	150	°C
保存温度	Tsig	-55 ~ +150	°C



内部接続図 / Connection Diagram



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta = 25 °C)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ しゃ断電流	$-I_{CB0}$	$-V_{CB} = 60 \text{ V}, I_E = 0$			1	mA
	$-I_{CB0}$	$V_{CB} = 80 \text{ V}, I_E = 0$			1	mA
コレクタ しゃ断電流	$-I_{CE0}$	$-V_{CB} = 30 \text{ V}, I_B = 0$			2	mA
	$-I_{CE0}$	$-V_{CB} = 40 \text{ V}, I_B = 0$			2	mA
エミッタしゃ断電流	$-I_{EB0}$	$-V_{EB} = 5 \text{ V}, I_C = 0$			2	mA
コレクタ・ エミッタ電圧	$-V_{CE0}$	$-I_C = 30 \text{ mA}, I_B = 0$	60			V
	$-V_{CE0}$	$-I_C = 30 \text{ mA}, I_B = 0$	80			V
直流電流増幅率	h_{FE1}	$-V_{CE} = 4 \text{ V}, I_C = 1 \text{ A}$	1000			
	h_{FE2}^*	$-V_{CE} = 4 \text{ V}, I_C = 2 \text{ A}$	1000		10000	
ベース・エミッタ電圧	$-V_{BE}$	$-V_{CE} = 4 \text{ V}, I_C = 2 \text{ A}$			2.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$-V_{CE(sat)}$	$-I_C = 2 \text{ A}, -I_B = 8 \text{ mA}$			2.5	V
ターンオン時間	t _{on}	$I_C = 2 \text{ A}, -I_{B1} = I_{B2} = 8 \text{ mA}$		0.2		μs
ターンオフ時間	t _{off}			2		μs

* h_{FE2} ランク分類 / h_{FE2} Classifications

Class	R	Q	P
h_{FE2}	1000 ~ 2500	2000 ~ 5000	4000 ~ 10000

